



英特尔和美光采用3-Bit-Per-Cell技术推出业界最高效的NAND产品

两家公司利用获奖的34纳米NAND工艺，实现了32Gb存储密度

Santa Clara, Calif., and Boise, Idaho , 2009年8月11日 – 英特尔公司 (Intel Corporation) 和美光科技股份有限公司 (Micron Technology Inc., 纽约证券交易所: MU) 今天宣布, 双方依靠其获奖的34纳米NAND工艺, 推出每单元储存3比特 (3-bit-per-cell, 简称3bps) 的多层单元 (MLC) NAND技术试用产品。这些芯片最适合用于闪存卡和USB驱动器等消费存储设备, 在这类应用场合中, 高密度和性价比是首要考虑的问题。

双方组建的NAND闪存合资企业IM Flash Technologies公司 (IMFT) 开发了3bpc NAND新技术, 并利用这项技术生产出了目前市场上尺寸最小、性价比最高的32Gb 3bpc NAND芯片面积为126mm², 将于2009年第四季度投入量产。两家公司不断致力于新的工艺微缩 (process shrink) 研发, 现在推出的3bpc NAND技术是其产品战略的重要组成部分, 也是为关键细分市场服务的有效途径。

美光公司内存事业部副总裁Brian Shirley说, “我们把3bpc NAND技术看作路线图的重要组成部分。我们也会继续推进NAND工艺微缩的研发, 从而在今后若干年为客戶提供世界一流的产品组合。今天发布的消息进一步表明, 美光和英特尔在34纳米NAND技术方面已经取得了重大的进展。我们盼望今年晚些时候推出2xnm技术。”

英特尔公司副总裁、英特尔NAND解决方案事业部总经理Randy Wilhelm说, “我们走向3bpc技术, 这是英特尔和美光在34纳米NAND开发过程中取得突出进展的又一个证明。这一里程碑为我们在2xnm硅加工工艺方面保持领先地位奠定了基础, 而这种2xnm工艺将有助于为客户节省成本, 拓展我们NAND解决方案的功能。”

相关链接

您还可通过其他途径了解美光和英特尔的最新新闻:

- 美光创新博客: www.micronblogs.com
- 美光Twitter: <http://twitter.com/microntechpr>
- 英特尔新闻室: www.intel.com/pressroom
- 英特尔博客: www.blogs.intel.com
- 英特尔Twitter: <http://twitter.com/intelnews>

关于英特尔公司

英特尔公司 (纳斯达克股票代码: INTC) 是芯片创新领域的全球领先厂商, 致力于开发技术、产品和计划, 不断改进人们的工作和生活方式。有关英特尔的详细情况请查阅: www.intel.com/pressroom和 <http://blogs.intel.com>。如需了解英特尔NAND闪存解决方案的详细情况, 请查阅: www.intel.com/go/ssd。

关于美光公司

美光科技股份有限公司 (Micron Technology, Inc.) 是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一。通过全球化的运营,美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、其他半导体组件以及存储器模块,用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。美光公司普通股代码为MU,在纽约证券交易所(NYSE)交易。如需了解美光科技股份有限公司的详细情况,请访问:www.micron.com。

©2009 Micron Technology, Inc. 和 Intel Corporation 版权所有。所有权利保留。信息可能发生变更,恕不另行通知。

Micron (美光) 和美光环绕标志是美光科技股份有限公司的商标。

Intel (英特尔) 是英特尔公司在美国和其他国家的商标。所有其他商标属其各自所有人财产。

本新闻稿包含有关3bpc 32 Gb

NAND设备生产的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与这些前瞻性陈述所含内容产生显著差异。请参考美光公司在并表基础上不时向美国证券交易委员会呈报的文件,特别是公司最新的10-K表和10-Q表。这些文件含有并明确了可能导致公司在合并报表基础上的实际业绩与我们的前瞻性陈述中所含内容产生重大差异的重要因素(参见“已知因素”章节)。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的,但我们不能对未来业绩、活动水平、表现或成绩做出保证。

CONTACT:

Kirstin Bordner
Micron Technology, Inc.
208-368-5487
kbordner@micron.com